

# Technische Information / Technical Information

Netz-Thyristor-Modul  
Phase Control Thyristor Module

# TZ 400 N 26

N

## Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzenperrspannung repetitive peak forward and reverse voltages	$T_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots T_{vj\ max}$	$V_{DRM}, V_{RRM}$	2600	V
Vorwärts-Stoßspitzenperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots T_{vj\ max}$	$V_{DSM}$	2600	V
Rückwärts-Stoßspitzenperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots T_{vj\ max}$	$V_{RSM}$	2700	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMS on-state current		$I_{TRMSM}$	1050	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 85^\circ\text{C}$ $T_C = 46^\circ\text{C}$	$I_{TAVM}$	400	A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, t_p = 10\text{ms}$	$I_{TSM}$	13000	A
Grenzlastintegral $I^2t$ -value	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, t_p = 10\text{ms}$	$I^2t$	845000	$\text{A}^2\text{s}$
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f = 50\text{Hz}, i_{GM} = 1\text{A}, di_G/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$	$(di_T/dt)_{cr}$	150	$\text{A}/\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,67 V_{DRM}$ 6. Kennbuchstabe / 6th letter F	$(dv_D/dt)_{cr}$	1000	$\text{V}/\mu\text{s}$

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, i_T = 1500\text{A}$	$V_T$	max.	1,88	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	$V_{(TO)}$	1,00		V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	$r_T$		0,50	$\text{m}\Omega$
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{V}$	$I_{GT}$	max.	250	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{V}$	$V_{GT}$	max.	2,2	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 6\text{V}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	$I_{GD}$	max.	10	mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	$V_{GD}$	max.	0,25	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{V}, R_A = 5\Omega$	$I_H$	max.	300	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6\text{V}, R_{GK} \geq 10\Omega$ $i_{GM} = 1\text{A}, di_G/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}, t_G = 20\mu\text{s}$	$I_L$	max.	1500	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ $V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$	$i_D, i_R$	max.	100	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^\circ\text{C}, i_{GM} = 1\text{A}, di_G/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$	$t_{gd}$	max.	4	$\mu\text{s}$
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\ max}, i_{TM} = 400\text{A}$ $V_{RM} = 100\text{V}, V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20/\mu\text{s}, -di_T/dt = 10\text{A}/\mu\text{s}$ 5. Kennbuchstabe / 5th letter O	$t_q$	typ.	300	$\mu\text{s}$
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{Hz}, t = 1\text{min}$ RMS, $f = 50\text{Hz}, t = 1\text{sec}$	$V_{ISOL}$		3,0 3,6	kV kV

# Technische Information / Technical Information

**euppec**

Netz-Thyristor-Modu  
Phase Control Thyristor Module **TZ 400 N 26**

N 

## Thermische Eigenschaften / Thermal properties:

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Modul / per module, $\Theta = 180^\circ \sin$ pro Modul / per module, DC	$R_{thJC}$	max. 0,065	°C/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module	$R_{thCK}$	max. 0,020	°C/W
Höchstzulässige Sperrsichttemperatur max. junction temperature		$T_{vj\ max}$	125	°C
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{cop}$	- 40...+125	°C
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$	- 40...+130	°C

## Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties:

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 3 page 3	
Si-Elemente mit Druckkontakt, Amplifying-Gate Si-pellets with pressure contact, amplifying-gate				
Innere Isolation internal insulation			AlN	
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung mounting torque	Toleranz / tolerance $\pm 15\%$	M1	5	Nm
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque	Toleranz / tolerance +5% / -10%	M2	12	Nm
Gewicht weight		G	typ. 900	g
Kriechstrecke creepage distance			15	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50Hz		50	m/s <sup>2</sup>

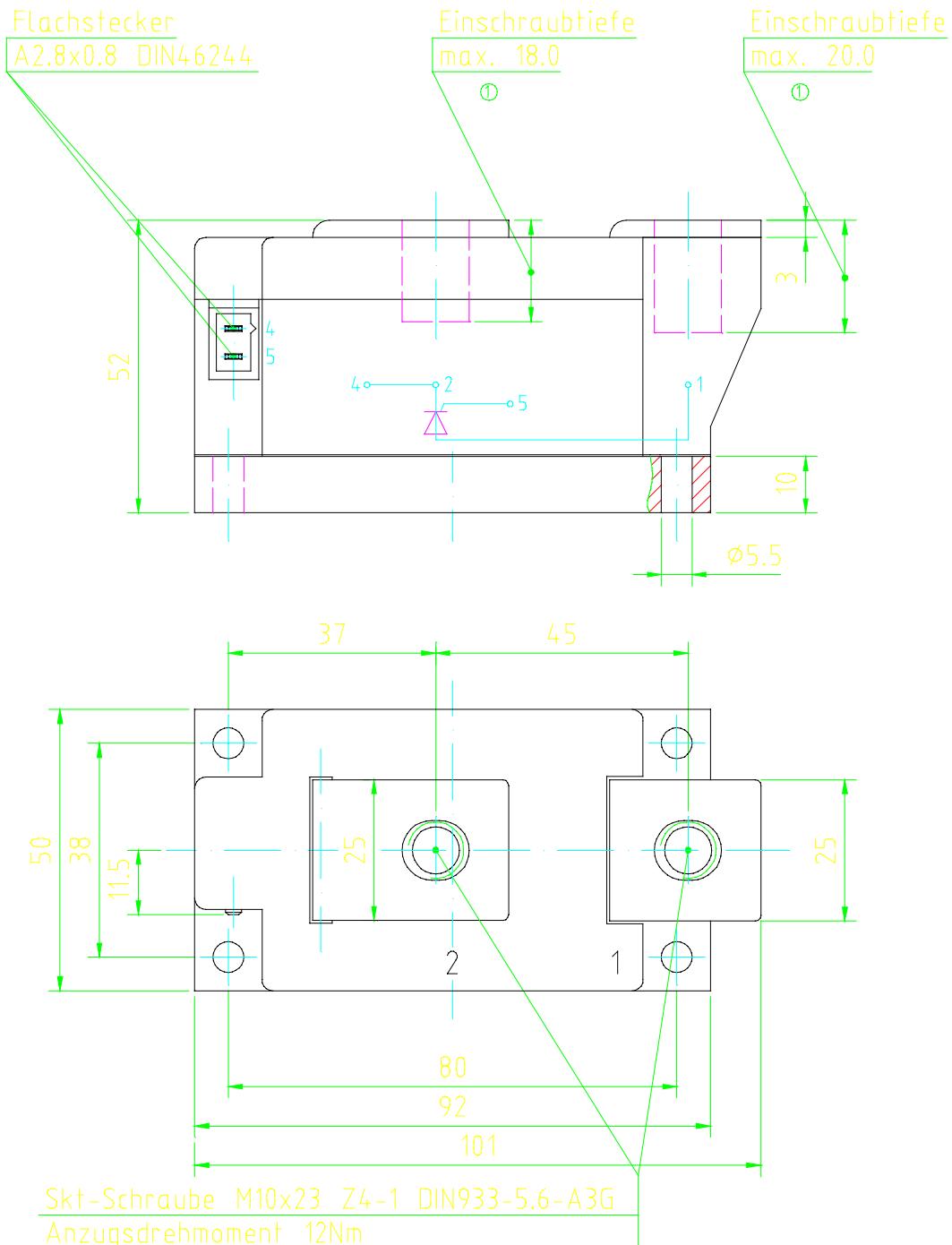
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. / This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

# Technische Information / Technical Information

**eupec**

Netz-Thyristor-Modu  
Phase Control Thyristor Module **TZ 400 N 26**

N



# Technische Information / Technical Information

Netz-Thyristor-Modu  
Phase Control Thyristor Module **TZ 400 N 26**

**eupc**

N



Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $i_{thJC}$  für DC

Analytical elements of transient thermal impedance  $i_{thJC}$  for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [\text{ }^{\circ}\text{C} / \text{W}]$	0,00137	0,00486	0,0114	0,0223	0,0221		
$\tau_n [\text{s}]$	0,00076	0,0086	0,101	0,56	3,12		

Analytische Funktion:  $Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$